

方形三维沟槽电极硅探测器相干性影响因素研究

为了研究方形三维沟槽电极硅探测器相邻单元之间相干性的影响因素问题，根据 Ramo 理论提出的电信号产生原理，本文以分析比重场为研究手段，利用仿真工具 Silvaco TCAD 仿真出方形三维沟槽电极硅探测器的结构，采取最小电离粒子（MIP）从探测器上部垂直入射的方式，通过改变高能粒子入射的位置和探测器的沟槽深度，来研究探测器相邻单元之间的相干性影响因素。

Primary author: Mr MA, Kuo (湘潭大学)

Co-authors: Mr LIAO, Chuan (湘潭大学); Mr LI, Zheng (湘潭大学)